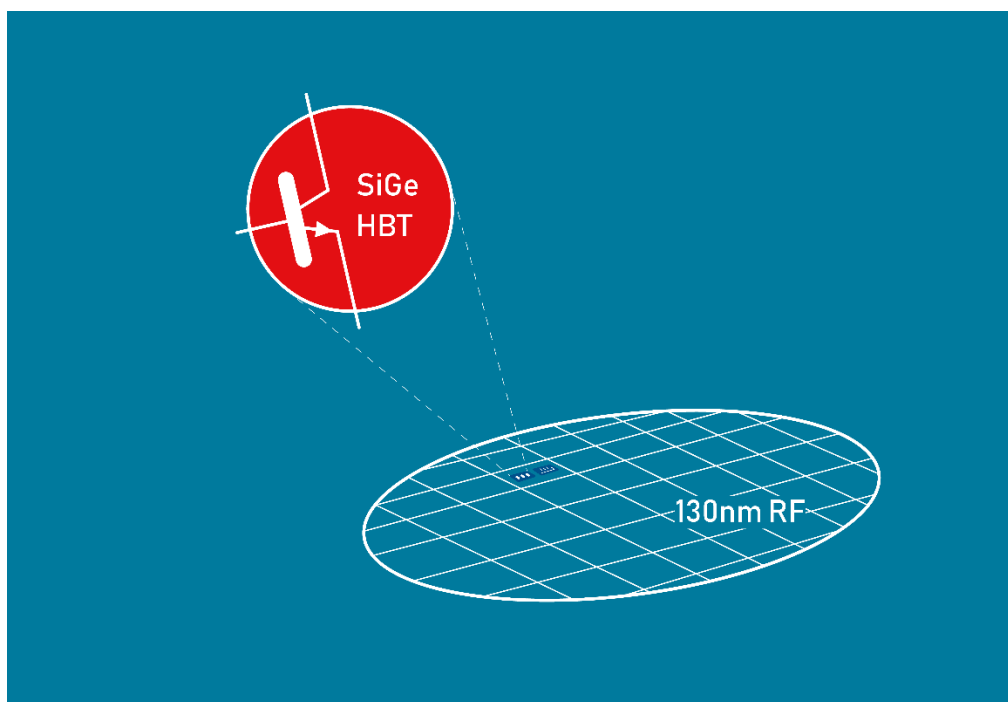




X-FAB 与莱布尼茨 IHP 研究所达成许可协议 推出创新的 130 纳米 SiGe BiCMOS 平台

中国北京，2022 年 9 月 13 日——全球公认的卓越的模拟/混合信号晶圆代工厂 X-FAB Silicon Foundries（“X-FAB”）与莱布尼茨 IHP 研究所今日共同宣布，将推出创新的 130 纳米 SiGe BiCMOS 平台，进一步扩大与莱布尼茨高性能微电子研究所（IHP）的长期合作关系。作为新协议的一部分，X-FAB 将获得 IHP 的尖端 SiGe 技术授权，将这一技术的性能优势带给大批量市场的客户群体。



130 纳米 SiGe BiCMOS 平台

新创建的 130 纳米平台显著加强了 X-FAB 的技术组合，提供了独特的解决方案，达到满足下一代通信要求所需的更高性能参数。受益于这项技术的领域包括 Wi-Fi 6（和未来的 Wi-Fi 7）接入点，以及下一代蜂窝基础设施（特别是 5G 毫米波与新兴 6G 标准）和车对车（V2V）通信；该技术还将在 +100GHz 雷达系统的开发中发挥关键作用，适用于汽车和消费类应用。

这项许可协议延续了 2021 年启动的合作，当时 X-FAB 的铜后道工艺被添加至 IHP 的 SG13S 和 SG13G2 前端技术中，以提高可支持的带宽数据。关于这一



创新的 SiGe 平台，X-FAB 将于 2022 年第四季度开始与选定的早期合作厂商开展原型开发项目。早期准入的 PDK 可实现原型设计，而量产将在 X-FAB 法国位于巴黎附近的工厂进行。

IHP 科学总监 Gerhard Kahmen 教授表示：“将 IHP 的 HBTs 整合至 X-FAB 的 RF 平台，将为客户打造真正与众不同的 SiGe BiCMOS 技术，这肯定会带来切实的性能优势。我们双方之间的技术转让，已成为工业与研究机构携手取得卓越成果的完美范例。”

“X-FAB 和 IHP 在融合我们各自优势资源开发前沿半导体解决方案领域拥有杰出的成绩；双方针对 SiGe 技术的最新协议将这一实践带入令人兴奋的全新阶段。” X-FAB RF 技术总监 Greg U'Ren 博士表示，“这是双方进一步推进 SiGe BiCMOS 相关创新的起点，涵盖了工业自动化、消费电子和车载等使用案例，将推动在未来几年内对通信领域的重新定义。”

缩略语：

BiCMOS	双极互补金属氧化物半导体
HBT	异质结双极型晶体管
mmW	毫米波
PDK	工艺设计套件
RF	射频
SiGe	锗硅

###

关于 X-FAB:

X-FAB 是领先的模拟/混合信号和 MEMS 晶圆代工集团，生产用于汽车、工业、消费、医疗和其它应用的硅晶圆。X-FAB 采用尺寸范围从 1.0 μ m 至 130nm 的模块化 CMOS 和 SOI 工艺，及其特色 SiC 与微机电系统（MEMS）长寿命工艺，为全球客户打造最高的质量标准、卓越的制造工艺和创新的解决方案。X-FAB 的模拟数字集成电路（混合信号 IC）、传感器 MEMS 在德国、法国、马来西亚和美国的六家生产基地生产，并在全球拥有约 4,000 名员工。www.xfab.com

关于 IHP:

IHP 作为莱布尼茨联合研究所的一部分，是欧洲领先的硅基系统和超高频电路与技术（包括新材料）研究中心。该研究所为无线和宽带通信、安全、医疗技术、工业 4.0、汽车工业及航空航天等应用领域开发创新的解决方案。IHP 拥有先进的工艺基础设施，包括 1500 平方米的 DIN EN ISO 14644-1 洁净室，用于为毫米波、THz 和光子学应用制



造合格的硅基射频技术与系统。通过内部设计套件的开发，技术模块的扩展迅速达到可靠且适用的水平。其旗舰技术包括世界最快、稳定和合格的 130 纳米 SiGe BiCMOS 工艺线（采用下一代高性能 SiGe HBT 技术的 SG13G2 和最新 SG13G3）。IHP 拥有约 360 名员工。www.ihp-microelectronics.com

欢迎扫码关注 **X-FAB** 官方微信公众号，了解更多精彩资讯：



媒体联系：

王伟

X-FAB 中国区市场经理

86-21-2050 1645

Angela.Wang@xfab.com

乔治

GeoMatrix Public Relations Ltd.

86-10-8595 9439

george.qiao@geomatrixpr.com